
	<h2 style="color: red;">FDP047N10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP047N10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 120A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP047N10.pdf</a> <a href="#">2.FDP047N10.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 50191 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP047N10
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50191 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	120A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	210nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15265pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FDP047N10 ist neu im Original, Suche FDP047N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP047N10 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP047N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP050</b> FSC FDP050 FSC</p>	 <p><b>FDP047N08</b> FDK America MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>	 <p><b>FDP047NA08A0</b> FSC FDP047NA08A0 FSC</p>	 <p><b>FDP047N08-F102</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO220-3</p>
 <p><b>FDP050AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP047N08A0</b> FSC FDP047N08A0 FSC</p>	 <p><b>FDP047N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 164A TO-220</p>	 <p><b>FDP050AN06A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-220AB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FDP027N08B	↔ FDP027N08B	⇒ FDP030N06	D FDP030N06	⇒ FDP030N06B_F102
⊣ FDP032N08	⊗ FDP032N08	D FDP032N08B	⇒ FDP036N10A	⇒ FDP036N10A
⊗ FDP038AN06A0	⊣ FDP038AN06A0	⊗ FDP038AN06A0	↔ FDP039N08B	⇒ FDP040N06
D FDP040N06	⊗ FDP045N10A	⊣ FDP045N10A	⊗ FDP047AN08	⇒ FDP047AN08A0
⇒ FDP047AN08A0	↔ FDP047AN08A0	⊗ FDP047N08	⊣ FDP047N08	⇒ FDP047N08A0
↔ FDP047N10	⇒ FDP050AN06A0	D FDP050AN06A0	⊗ FDP050AN06A0	⊣ FDP053N08B
⊗ FDP053N08B_F102	D FDP054N10	⇒ FDP054N10	↔ FDP060AN08A0	⇒ FDP060AN08A0
⊣ FDP060AN08A0	⊗ FDP060N08A0	↔ FDP060N08A0	⇒ FDP068AN08A0	⇒ FDP070AN06A0
⊗ FDP070AN06A0	⊣ FDP070AN06A0	⊗ FDP075N15A	D FDP075N15A	⇒ FDP083N15A
↔ FDP083N15A	⊗ FDP083N15A_F102	⊣ FDP085N10A	⊗ FDP085N10A	⇒ FDP085N10A_F102

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited